

# Intel et Micron se lancent dans la mémoire flash gravée en 20 nm

**Intel et Micron** viennent d'annoncer le lancement d'un nouveau procédé de gravure en **20 nm**, qui sera appliqué à la mémoire **flash NAND MLC** (*Multi-level cell*). Il a d'ores et déjà permis de créer une cellule mémoire de **8 Go**, d'une surface de seulement **118 mm<sup>2</sup>**.

L'espace occupé est ainsi réduit **de 30 % à 40 %** par rapport aux modules 25 nm actuels. Cette évolution permettra de créer des composants flash de 128 Go... **plus petits qu'un timbre-poste**. Une avancée notable pour les terminaux mobiles, qui font une chasse permanente à l'espace occupé par les composants.

La gravure en 20 nm devrait également permettre de **réduire la consommation électrique** des modules flash, et – à terme – leur coût, un plus grand nombre de puces pouvant être gravées à la fois. La mise en production des unités flash 20 nm de 8 Go devrait démarrer **au cours du second semestre 2011**. Une cellule de 16 Go sera proposée ultérieurement.

**Tom Rampone**, vice-président d'Intel chargé du *non-volatile memory solutions group*, précise que « *la joint-venture Intel-Micron (IMFT) est un modèle pour le secteur industriel, car elle conforte notre leadership en termes de gravure et nous autorise à opérer de rapides transitions de tout notre réseau de production, vers des lithographies plus fines.* »

Petite précision pour celles et ceux qui s'interrogent sur la possible adoption de cette finesse de gravure dans le monde des processeurs : le 20 nm reste encore en cours de mise au point. Aussi, il n'est utilisable que dans le cadre **de composants très simples**, comme de la mémoire (volatile ou non). La limite est donc pour le moment technique et non stratégique.